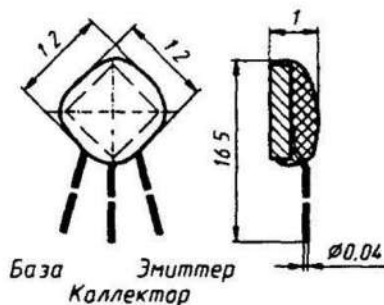


**2Т214А9, 2Т214Б9, 2Т214В9, 2Т214Г9,  
2Т214Д9, 2Т214Е9, 2Т214А-1, 2Т214Б-1, 2Т214В-1,  
2Т214Г-1, 2Т214Д-1, 2Т214Е-1, КТ214А-1, КТ214Б-1,  
КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1**

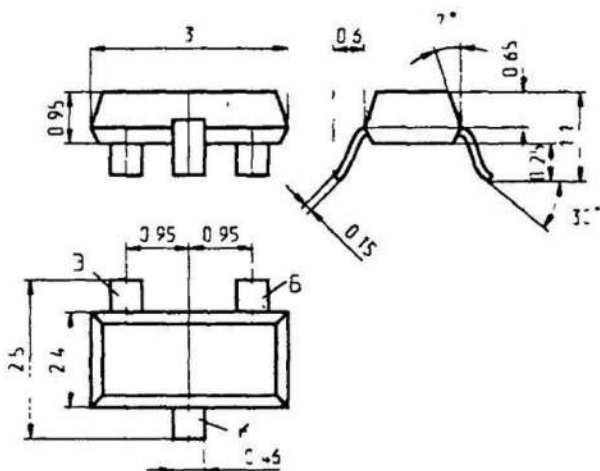
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p*. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах герметизированной аппаратуры. Транзисторы 2Т214(А9-Е9) выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами, 2Т214(А-1-Е-1), КТ214(А-1-Е-1) бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием. Тип прибора указывается в этикетке и на таре-спутнике.

Масса транзистора в пластмассовом корпусе не более 0,1 г, бескорпусного не более 0,01 г.

2Т214(А-1-Е-1) КТ214(А-1-Е-1)



2Т214(А9-Е9)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока  
в схеме ОЭ:

при  $T = +25^\circ\text{C}$ ,  $U_{кб} = 5\text{ В}$ ,  $I_3 = 10\text{ мА}$ :

2Т214А9, 2Т214А-1, КТ214А-1, не менее .....	20
2Т214В9, 2Т214В-1, КТ214В-1.....	30...90
2Т214В9, 2Т214Г9, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, КТ214В-1, КТ214Г-1.....	40...120
$U_{КБ} = 1 \text{ В}, I_3 = 40 \text{ мкА}$ , не менее:	
2Т214Д9, 2Т214Д-1, КТ214Д-1 .....	80
2Т214Е9, 2Т214Е-1, КТ214Е-1 .....	40
при $T = T_{\text{МИН}}$ , $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 10 \text{ мА}$ :	
2Т214А9, 2Т214А-1, КТ214А-1, не менее .....	7
2Т214В9, 2Т214В-1, КТ214В-1.....	10...90
2Т214В9, 2Т214Г9, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, КТ214В-1, КТ214Г-1.....	15...120
$U_{КБ} = 1 \text{ В}, I_3 = 40 \text{ мкА}$ , не менее:	
2Т214Д9, 2Т214Д-1, КТ214Д-1 .....	25
2Т214Е9, 2Т214Е-1, КТ214Е-1 .....	15
при $T = T_{\text{МАКС}}$ , $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 10 \text{ мА}$ :	
2Т214А9, 2Т214А-1, КТ214А-1, не менее .....	20
2Т214В9, 2Т214В-1, КТ214В-1.....	30...150
2Т214В9, 2Т214Г9, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, КТ214В-1, КТ214Г-1.....	40...200
$U_{КБ} = 1 \text{ В}, I_3 = 40 \text{ мкА}$ , не менее:	
2Т214Д9, 2Т214Д-1, КТ214Д-1 .....	80
2Т214Е9, 2Т214Е-1, КТ214Е-1 .....	40
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 1 \text{ мА}$ .....	5*...20*... 30* МГц
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 2 \text{ мА}$ , не более .....	5 нс
типовое значение.....	1* нс
Коэффициент шума на $f = 1 \text{ кГц}$ при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ , $I_3 = 40 \text{ мкА}$ , $R_T = 10 \text{ кОм}$ для 2Т214Д9, 2Т214Д-1, КТ214Д-1.....	1,8*...3,5*... 5* дБ
Граничное напряжение при $I_K = 10 \text{ мА}$ , не менее:	
2Т214А9, 2Т214В9, 2Т214А-1, 2Т214В-1, КТ214А-1, КТ214В-1 .....	80 В
2Т214В9, 2Т214В-1, КТ214В-1.....	60 В
2Т214Г9, 2Т214Г-1, КТ214Г-1 .....	40 В
2Т214Д9, 2Т214Д-1, КТ214Д-1 .....	30 В
2Т214Е9, 2Т214Е-1, КТ214Е-1 .....	20 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 10 \text{ мА}$ , $I_B = 1 \text{ мА}$ , не более:	
2Т214А-1, 2Т214Б-1, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, 2Т214Д-1, 2Т214Е-1 .....	0,45 В
2Т214А9, 2Т214Б9, 2Т214В9, 2Т214Г9, 2Т214Д9, 2Т214Е9, КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1 .....	0,6 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 10 \text{ А}$ , $I_B = 1 \text{ мА}$ , не более .....	1,2* В
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ \text{ макс}}$ , $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$ , не более:	
$T = +25 \text{ }^\circ\text{С}$ и $T = T_{\text{мин}}$ .....	1 мкА
$T = T_{\text{макс}}$ .....	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = U_{ЭБ \text{ макс}}$ не более .....	10 мкА
Входное сопротивление в режиме малого сиг- нала при $U_{КЭ} = 5 \text{ В}$ , $I_K = 2 \text{ мА}$ , $f = 800 \text{ Гц}$ .....	1,2*...2,5*... 10* кОм
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ .....	9,5*...12*... 30 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5 \text{ В}$	9,6*...40*... 100 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$ :	
2Т214А9, 2Т214А-1, КТ214А-1 .....	100 В
2Т214Б9, 2Т214Б-1, КТ214Б-1 .....	80 В
2Т214В9, 2Т214В-1, КТ214В-1 .....	80 В
2Т214Г9, 2Т214Г-1, КТ214Г-1 .....	60 В
2Т214Д9, 2Т214Е9, 2Т214Д-1, 2Т214Е-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1 .....	30 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
2Т214А9, 2Т214А-1, КТ214А-1 .....	30 В
2Т214Б9, 2Т214В9, 2Т214Г9, 2Т214Д9, 2Т214Б-1, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, 2Т214Д-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1 .....	7 В
2Т214Е9, 2Т214Е-1, КТ214Е-1 .....	20 В
Постоянный ток коллектора .....	50 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 \text{ мкс}$ , $Q = 100$ .....	100 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup>:

при  $T = T_{\text{мин}} \dots + 25 \text{ } ^\circ\text{C}$ :

2T214A9, 2T214B9, 2T214B9, 2T214Г9, 2T214Д9, 2T214Е9 .....	200 мВт
2T214А-1, 2T214Б-1, 2T214В-1, 2T214Г-1, 2T214Д-1, 2T214Е-1, КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1 .....	50 мВт

при  $T = T_{\text{макс}}$ :

2T214A9, 2T214B9, 2T214B9, 2T214Г9, 2T214Д9, 2T214Е9 .....	80 мВт
2T214А-1, 2T214Б-1, 2T214В-1, 2T214Г-1, 2T214Д-1, 2T214Е-1, КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1 .....	20 мВт

Тепловое сопротивление переход—среда:

2T214A9, 2T214B9, 2T214B9, 2T214Г9, 2T214Д9, 2T214Е9 .....	0,5 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$
2T214А-1, 2T214Б-1, 2T214В-1, 2T214Г-1, 2T214Д-1, 2T214Е-1, КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1 .....	2 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$

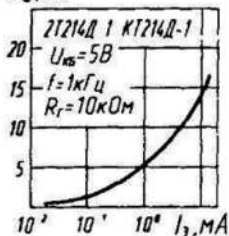
Температура р-п перехода ..... +125  $^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды:

2T214A9, 2T214B9, 2T214B9, 2T214Г9, 2T214Д9, 2T214Е9 .....	-60...+85 $^\circ\text{C}$
2T214А-1, 2T214Б-1, 2T214В-1, 2T214Г-1, 2T214Д-1, 2T214Е-1 .....	-60...+100 $^\circ\text{C}$
КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1 .....	-45...+85 $^\circ\text{C}$

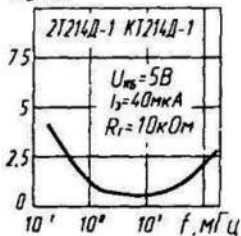
<sup>1</sup> При  $T > +25 \text{ } ^\circ\text{C}$  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора уменьшается линейно.

$K_{\text{ш}}, \text{дБ}$



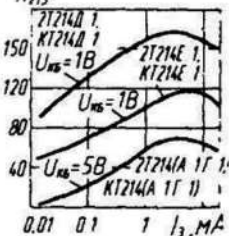
Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера

$K_{\text{ш}}, \text{дБ}$



Зависимость коэффициента шума от частоты

$\eta_{213}$



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера